

Speicherdröseln
für hohe Ströme und Frequenzen bis 300 kHz
40 ... 100 A
0,011 ... 0,077 mH

Baureihe CHI 210
Type CHI 213 G/...

Anwendungen:

In getakteten Netzteilen mit hohen Taktfrequenzen, überall, wo hohe Strombelastung bei kleinen Verlusten gefordert wird.



Nennspannung bis 500 V~	Betriebstemperatur -40 °C...+125 °C
Prüfspannung/Test voltage/Tension d'essai (ohne)	Geprüft nach EN 138000
Nenninduktivität +20% -20% bei 10 kHz	Bauform stehend, gesockelt, PIN-Raster

Vorteile:

- Hohe Sättigungsinduktion
- Hohes Speichervermögen
- Hohe Taktfrequenz
- Betriebstemperatur max. 125 °C
- Geringe Verluste
- Minimale Streuinduktivität
- Minimales magnetisches Streufeld
- Geringer Platzbedarf
- Nach UL 94 V-0

Technische Daten

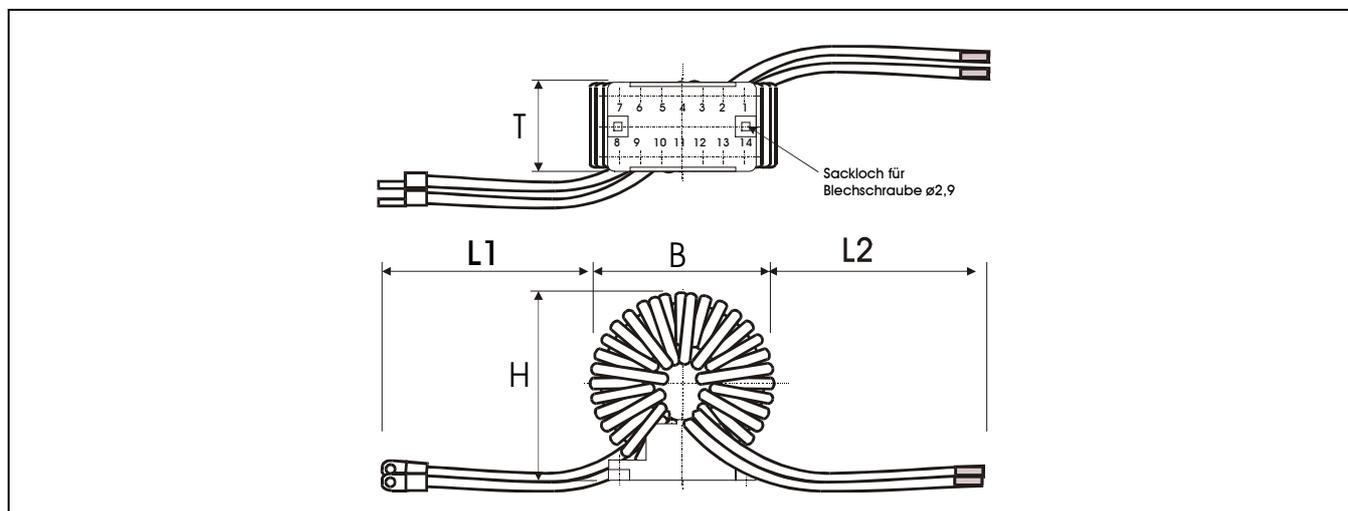
Type	BV-Nr.	Nenninduktivität L_N (mH) je Wicklung	Nennstrom I_N (A)	Gleichstromwiderstand R_{CU} (m Ω) je Wicklung
CHI 213 G/40/0,077	942873	0,077	40	7
CHI 213 G/50/0,043	942874	0,043	50	5
CHI 213 G/60/0,030	942875	0,030	60	4
CHI 213 G/70/0,022	942876	0,022	70	3
CHI 213 G/85/0,015	942877	0,015	85	2,8
CHI 213 G/100/0,011	942878	0,011	100	2,3

Frequenz bis 300 kHz

Frequency up to 300 kHz

Fréquence jusqu'à 300 kHz

Maßbild

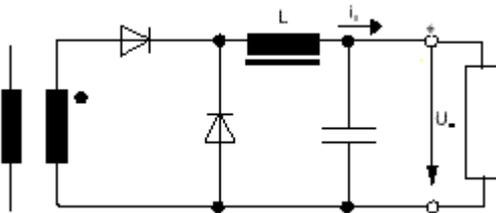


Type	BV-Nr.	B [mm]	H [mm]	T [mm]	l [mm]	Schaltung
CHI 213 G/40/0,077	942873	70	69	30	(Länge und Konfektionierung der Anschlüsse in Bestellung mit angeben)	
CHI 213 G/50/0,043	942874					
CHI 213 G/60/0,030	942875					
CHI 213 G/70/0,022	942876					
CHI 213 G/85/0,015	942877					
CHI 213 G/100/0,011	942878					

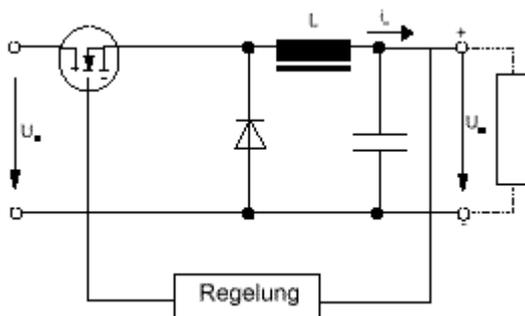
Speicher- und Siebdrosseln

Grundlagen

In Schaltnetzteilen, die nach dem Durchflußwandlerprinzip arbeiten, sowie in getakteten Längsreglern, werden lineare Speicherdrosseln eingesetzt. Deren Aufgabe ist es, den pulsierenden Gleichstrom zu glätten, indem sie Energie während der Stromflußzeit speichern und in den Pausen den Stromfluß im Lastkreis aufrecht erhalten. Erforderlich sind Induktivitäten mit hoher Gleichstromvorbelastbarkeit. Speicherdrosseln in modernen Stromversorgungen müssen daher hohen Anforderungen gerecht werden, wie beispielsweise hohe Speicherenergie in kleinem Bauvolumen und geringe Verluste bei hohen Taktfrequenzen. Ferner wird ein kostengünstiger Aufbau gefordert.



Speicherdrossel im Ausgangskreis eines Durchflußwandlers



Speicherdrossel L in einem Schaltregler

Gleichstromvorbelastung

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den typischen normierten Verlauf der Induktivität L über der Gleichstromvorbelastung I bei Raumtemperatur.

